# 2. TRANZYSTORY

#### Wykaz oznaczeń parametrów technicznych

```
pojemność kolektor - baza
CCBO
        pojemność sprzężenia zwrotnego w układzie wspólnego emitera /OE/
C<sub>12es</sub>
        pojemność sprzężenia zwrotnego w układzie wspólnego źródła /OS/
C 1288
        częstotliwość pomiarowa
f<sub>p</sub>
        częstotliwość graniczna
f
        współczynnik szumów
        małosygnałowy zwarciowy współcsynnik przenessenia prądowego w OE
        prad bazy
In
        prad kolektora
Ic
        prąd drenu
I_n
        prąd drenu przy zwarciu bramka - źródło /U<sub>GS</sub> = 0/ i przy określonym U<sub>DS</sub>
IDSS
        prąd bramki
IG
        moc strat w kolektorze
Pc
        moc całkowita
Ptot
         stała czasowa sprzężenia zwrotnego przy w.cz.
r<sub>bb</sub>, c
         temperatura otoczenia
tamb
         temperatura obudowy
tcase
         temperatura złącza
toff
         czas wyłączania
         czas włączania
ton
         czas przełączania
t<sub>s</sub>
         napięcie kolektor - baza
UCB
         napięcie kolektor - baza, otwarty emiter
UCBO
         napiecie kolektor - emiter
UCE
         napięcie kolektor - emiter, otwarta basa
UCEO
         napiecie kolektor - emiter, basa swarta
UCES
         napiecie emiter - baza, otwarty kolektor
UEBO
         napiecie dren - źródło
UDS
         napiecie bramka - dren
v_{\rm gp}
UGS
         napiecie stałe bramka - źródło
UGS off napiecie odcięcie bramka - źródło
```

### 2.1. Tranzystory małej częstotliwości małej mocy

				Parame	etry d	opuszc	zalne	$/t_{amb} = 25^{\circ}C$	/		
		СВО	UCEO	G <sup>EBO</sup>	ıc	Ptot	tj		,		
								t amb	tstg	Grupa	U
	naczenie wyrobu						0	°c	°c		
		V	v	V	mA	Wat	°c	*C*	C.		
		max	max	max	max	max	max				min
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BC	107	50	45	5	100	300	175	-40 +125	-55 +150	A B	110 200
BC	108	30	20	5	100	300	175	-40 +125	-55 +150	A B C	110 200 400
ВС	109	30	20	5	100	300	175	-40 +125	-55 +150	B C	200
ВС	147	50	45	6	100	300	125	-40 +125	-55 +125	A B	110 200
ВС	: 148	30	20	5	100	300	125	-40 +125	-55 +125	A B	110 200
										С	400
ВС	149	30	20	5	100	300	125	-40 +125	-55 +125	, B	200 400
ВС	: 157	50	45	5	100	300	125	-40 +125	-55 +125	VI A	65 110
BC	: 158	30	25	5	100	300	125	-40 +125	-55 +125	VI A B	65 110 200
BC	: 159	25	20	5	100	300	125	-40 +125	-55 +125	A B	110 200
ВС	2 177	50	45	5	100	300	175	-40 +125	-55 +175	VI A B	65 110 200
BC	2 178	30	25	5	100	300	175	-40 +12!	-55 +175	VI A B	65 110 200
ВС	179	25	20	5	100	300	175	-40 +120	-55 +175	A B	110 200
ВС	211	80	40	5	1000	800	175	-40 +12	5 -65 +175	6 10	40 <sup>2</sup> 60 <sup>2</sup> 100 <sup>2</sup>
							-			16	1002

h <sub>21E</sub> <sub>2E</sub> = 5 V	· -	Paran	etry ch	arakter	ystycz	ne /tam	ab = 25°C/				
h <sub>21E</sub>		h <sub>2</sub>	10	fT	C <sub>CBO</sub> I	rzy	UCE sat	P	N		
		U <sub>CE</sub> =	5 V		j.	UCE'	1 <sub>C</sub> = 10 mA	U <sub>CE</sub> = 5 V	n-p-n		
. = 2	1	1 c = 1				CE	I <sub>B</sub> = 0,5 mA	I <sub>C</sub> = 0,2 mA	P p-n-p	Zasto- sowa- nie	Obudowa
<del>,</del>				MHz	pF	V	v	фВ			
typ/	max	min	max	min /typ/	max /typ/		max /typ/	BAX			
11			12	13	14	15	16	17	18	19	20
	240 480	125 240	260 500	150	6	10	0,25	10	N	<b>a</b>	CE 22
	240 480 850	125 240 450	260 500 900	150	6	10	0,25	10	N	a ·	CE 22
	480 850	240 450	500 900	150	6	10	0,25		И	b	CE 22
e.	240 480	125 240	260 500	150	4,5	10	0,25	<b>‡</b> 0	N	•	CE 36
•	240 480 850	125 240 450	260 500 900	150	4,5	10	0,25	<b>2</b> 0 °	N	•	CE 36
	480 850	240 450	500 900	150	4,5	10	0,25		и •	b	CE 30
	150 240	75 125	150 260	/150/	6	10	0,2	10	P	0	CE 3
	150 240 480	75 125 240	150 260 500	/150/	6	10	0,2	10	P	C	CE 3
	240 480	125 240	260 500	/150/	6	10	0,2	4	P	b	CE 3
	150 240 480	75 125 240	150 260 500	100	, 7	10	/0,1/	10	P	•	CE 2
	150 240 480	75 125 240	150 260 500	100	7	10	/0,1/	10	P	C	CF 2
	240 480	125 240	260 500	100	7	10	/0,1/	•	P	b	CE 2
	100 <sup>2</sup> / 160 <sup>2</sup> / 250 <sup>2</sup> /			50	25	/10/	13/		N	•	CE 2

. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<del></del>	11	
BC 211 A	<b>10</b> 0	60	5	1000	800	175	-40 +125	-65 +175	6 10 16	40 <sup>2</sup> / 60 <sup>2</sup> / 100 <sup>2</sup> /		100 <mark>2</mark> 1602 250
BC 237	45	45	6	100	300	150	-25 +85	-55 +150	A B	110 200		240 480
BC 238	20	20	5	100	300	150	-25 +85	-55 +150	В	110 200 450		240 480 900
BC 239	20	20	5	100	300	150	-25 +85	-55 +150		200 450		480 900
BC 307	50	45 °	5	100	300	150	-25 +85	-55 +150	VI A	65 110		150 240
BC 308	30	25	5	100	300	150	-25 +85	-55 +150	VI A B	65 110 200		150 240 480
BC 309	25	20	5	100	300	150	-25 +85	-55 +150	A B	110 200	·	240 480
BC 313	60	40	5	1000	800	175	-40 +125	-65 +175	6 10 16	40 <sup>2</sup> / 60 <sup>2</sup> / 100 <sup>2</sup> /		100 160 250
BC 337	50	45	5	800	500	150	-25 +85	-55 +150	10 16 25	604/ 1004/ 1604/		160 250 400
BC 338	30	25	5	800	500	150	-25 +85	-55 +150	10 16 25	604/ 1004/ 160	,	160 250 400
BC 393	180	180	6	100	400	200	-40 +125	-55 +200	1 .	505/		
BC 413	45	30	5	100	300	150	-25 +125	-55 +150	B C	200 400	_	480 850
BC 414	50	45	5	100	300	150	-25 +125	-55 +150	B C	200		480 850
BC 527	45	45	5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	1 11 111	90 180 360		24 0 45 0 85 0
BC 528	20	20	5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	I II III	90 180 360	÷	24 ( 48 ( 85 (
BC 627	45	45	5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	A B C	1.	/180/ /290/ /520/	
BC 628	20	20	.5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	A B C		/180/ /290/ /520/	
BCE 107 BCE 107 R	45	45	5	100	150	175	-40 +12	5 -55 +175	A B		/180/ /290/	

	12		13	14	15	16	17	18	19	20
1002/ 1602/ 2502/			50	25	/10/	13/	•	N	6	CE 23
240 180 ,	125 240	260 500	150	. 4,5	10	0,25	10	N	đ	CE 35
240 180 900	125 240 450	260 500 900	150	4,5	10	0,25	10	<b>N</b>	đ	CE 35
180 900	240 450	500 900	150	4,5	10	0,25	4	N	ъ	CE 35
150 240	75 125	150 260	100	6	10	0,2	10	<b>P</b>	<b>a</b>	CE 35
150 240 480	75 125 240	150 260 500	100	6	10	0,2	10	<b>P</b>	a	CE 35
240 480	125 240	260 500	100	6	10	0,2	4	P	ъ	CE 35
100 <sup>2</sup> / 160 <sup>2</sup> / 250 <sup>2</sup> /			50	30	/10/	13/		P	e	CE 23
1604/ 2504/ 4004/			/150/	/7/	/10/	0,71/		N	C	CE 35
1604/ 2504/ 400			/150/	/7/	/10/	0,71/		N	c	CE 35
			50	7	10	/0,25/		P	•	CE 22
480 850	240 450	500 900	/250/	/2,5	10	0,25	2,5	N	b	CE 35
480 850	240 450	500 900	/250/	/2,5	10	0,25	2,5	N	þ	CE 35
240 450 850	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	0,25	10	N	•	CE 22
240 480 850	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	0,25	10	N	c	CE 22
	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5	_0,25	10	N	C	CE 35
	100 210 400	240 450 900	150	4,5	5 5	0,25	10	, N	C	CE 35
	125 240	260 500	150	6	10	0,25	10	И	đ	CE 45

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BCE 108 DCE 108 R	20	20	5	100	150	175	-40 .,, +125	-55 +175	A B C	
BCE 109 BCE 109 R	20	20	5	100	150	175	-40 +125	-55 +175	B C	,
BCE 177 BCE 177 R	50	45	5	100	150	175	-40 +125	-55 +175	VI A B	65 110 200
BCE 178 BCE 178 R	30	25	<b>5</b>	100	150	175	<b>-40</b> +125	-55 +175	VI A B C	65 110 200 400
BCE 179 BCE 179 R	25	20	5	100	150	175	-40 +125	-55 +175	B C	200 400
BCW 29 BCW 29 R	30	20	5	100	200	150	-40 +125	-55 +150		120
BCW 30 BCW 30 R	30	20	8	100	200	150	-40 +125	-55 +150		260
BCW 31 BCW 31 R	30	20	5	100	200	150	-40 +125	-55 +150	••	110
BCW 32 BCW 32.R	30	20	5	100	200	150	-40 +125	-55 +150		200
BCW 33 BCW 33 R	30	20	5	100	200	150	-40 +125	-55 +150		420
BCW 69 BCW 69 R	50	45	5	100	200	150	-40 +125			120
BCW 70 BCW 70 R	50	45	5	100	200	150	-40 +125	-55 +150		260
BCW 71 BCW 71 R	50	45	5	100	200	150	-40 +125			110
BCW 72 BCW 72 R	50	45	5	100	200	150	-40 +125	-55 , +150		200
BCX 17 <sup>X</sup> BCX 17 R <sup>X</sup>		45	5	1000	310	150	-40 +125	-65 +150		1004/
BCX 18 <sup>X</sup> BCX 18 R <sup>X</sup>		25	5	1000	310	150	-40 +125	-65 +150		4004/
BCX 19 <sup>X</sup> BCX 19 R <sup>X</sup>		45	5	1000	310	150	-40 +125	-65 +150		1004/
BCX 20 RX		25	5	1000	310	150	-40 +125	-65 +150		1004/

a stopnie wejściowe małej częstotliwości; b stopnie małej częstotliwości niskoszumowe stopnie sterujące i wyjściowe średniej mocy

1/ przy I<sub>C</sub> = 0,5 A; I<sub>B</sub> = 0,05 A; 

2/ przy I<sub>C</sub> = 150 mA; U<sub>CE</sub> = 2 V; 

3/ przy I<sub>C</sub> = 1 A;

x nowe uruchomienia

	11		1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
ı	/180/ /290/ /520/		125 240 <b>45</b> 0	260 500 900	150	6	10	Q <sub>4</sub> 25	10	N	\ <b>d</b>	CE 45
	/290/ /520/		240 450	500 900	150	6	10	0,25	•	n	đ	CE 45
5 0		150 240 480	75 125 240	150 260 500	/250/	6	10	0,2	40	P	đ	CE 45
5 0 0		150 240 480 850	75 125 240 450	150 260 500 900	/250/	6	10	0,2	<b>10</b>	P	đ	CE 45
0	· ·	430 850	240 450	500 900	/250/	6	10	0,2	<b>4</b> ,	P	a	CE 45
Q		215			/150/	7	10	0,3	10	₽	•	CE 46
0		500			/150/	7	10	0,3	10	æ	đ	CE 40
0		220	! !		/300/	4	10	0,25	10	N	đ	CE 4
0		450			/300/	4	10	0,25	10	N	đ	CE 4
0		800	*		/300/	4	10	0,25	10	N	đ	CE 4
)		215			/150/	7	10	0,3	10	P	a	CE 4
0		500			/150/	7	40	0,3	10	P	d	CE 4
0		220			/300/	4	40	0,25	10	<b>N</b> .	a	CE 4
0		450			/300/	4	10	0,25	10	N	đ	CE 4
04/		6004/			100	8	10	0,61/	•	P	đ	CR 4
04/		6004/			100	8	10	0,61/		P	d	CE 4
ю4/		6004/			200	5	10	0,61/		N	đ	CE 4
04/		6004/			200	5	10	0,61/		N	a	CE 4

szumowe; c stopnie wejściowe i sterujące małej częstotliwości; d układy hybrydowe;

1 A;  $I_B = 0,1$  A;  $^{4/}$  przy  $I_C = 100$  mA;  $U_{CL} = 1$  V  $^{5/}$  przy  $I_C = 10$  mA;  $U_{CE} = 10$  V

2.2. Tranzystory malej cząstotliwości malej mocy specjalne

							• .				<del> </del>	<del></del>		
		į	down			82	CE 45	हु <b>१</b>	CE 45	CE 48	CE 45	35 43 35	CE 22	CE 22
		Zasto-	BOWe-			1.1	4	₩.	4	ਚ	4	ರ	•	•
	×	4 4	d-d-d			16	*	*	z	p.	ρ.	p <sub>a</sub>	×	z
	•			#	Xen	27	9	9	4	9	10	•	10	10
= 25°C/	UCE set	Ic = 10 mA	IB = 0,5 mA	<b>&gt;</b>	Lyp/	27	0,25	0,25	0,25	6,0	6,0	6.0	0,20	0,20
	he.s.	ncis	/CE/	Λ		53	97	9	9	8	10	10	10	9
CERS /	CcB0			2	N N	12	•	•	•	•	•	•	4,5	4,5
erysty	L			MA	min/typ/	11	150	997	720	/250/	/250/	/250/	160	150
arakt		5 V 2 mA	1 KHS		#eX	10	200	900	28	150 260 500	8000	88	200	<b>966</b>
Parametry charakterystyczne /tamb	<sup>b</sup> 210	uce =	) H		ate	1	125	125 240 450	240	12 125 240	25,22	240 450	22.2	277 2024 2024
Param		۸	ä		MAN					150 240 480	150 240 480 850	850 850	75 780 780	240 480 820
	P21E	10 11	N .		/typ/	6	/180/	/180/ /290/ /520/	/290/		·			
`		n	, r		min					1110 200	\$000 \$000 \$000 \$000	88	200	, 488 688
		Grupe			<i>(</i> '	8	48	<b>∢</b> ⋒∪	a U	5 4 m	Z 4 m o	W O.	∢m	<b>∢</b> #0
/2°25	1,77			ပိ	BAX	7	175	115	178	175	175	175	116	175
	Ptot			16	BBX	8	150	150	120	150	150	150	- 8 	8
granicane /tamb	J <sub>I</sub>			P. P.	жеж	10	100	8	100	100	100	61	7	100
ranica	UEBO			Λ	BBX	4	, <b>xo</b>	10	.10	10	NO	ю	ю	10
	UCEO			>	mex	6	45	50	80	3	28	. 28	**	8
Parametry	UCBO			>	ERX	63	45	50	50	92	8	28	8	<b>8</b>
	Oznaczenie Wyrobu					1	BCAE 07 B	BCAE 08 BCAE 08 R	BCAE 09 R	BCAE 77 B	BCAE 78 BCAE 78 R	BCAE 79 B	BCAP OT	BCAP 08

18	22	83	eg S	23	23 23 23	8 8	22 23 28	CE 23
F	<del>3</del> –	9 9	<u> </u>	ਰ- -	E C	S	<u> </u>	5
11	*	•	•	•	•	•	₩ .	•
16	Z	z	z	4	ρ,	ρ.	Δ,	e,
12	4				10	10	4	
14	0,20	11/	11/	11/	0,5	0,2	0,2	/0,25/
13	10	/10/	/10/	/10/	10	10	10	10
12	4,5	25	22	30	<b>-</b>	F	-	t-
11	150	90	20	20	/100/	/100/	/100/	50
	500 900		5		150 260 500	150 260 500	260	
10	240 450				75 125 240	75 125 240	125 240	
	480 850	100 <sup>2</sup> / 160 <sup>2</sup> / 250 <sup>2</sup> /	100 <sup>2</sup> / 160 <sup>2</sup> / 250 <sup>2</sup> /	1002/ 1602/ 2502/	150 240 480	150 240 480	240 480	
đ					. X 1.			
	200 400	40 <sup>2</sup> / 60 <sup>2</sup> / 100 <sup>2</sup> /	402/ 502/ 1002/	405/ 602/ 10002/	65 110 200	65 110 200	200	503/
80	( ສວ	9 10 10 10	100,	10 10 16	V A B	Z 4g	<b>₹</b> Ø	
2	175	175	175	175	175	17.5	175	300
9	300	800	800	008	300	300	300	8
ю	100	1000	1000	1000	91	8	8	8
4	່າວ	ю	ro C	ю	10	ю	ю	ø
ဗ	08	40	8	40	15	22	20	180
2	70	80	8	8	8	ဓ္ဓ	22	180
1	BCAP 09	BCAP 11	BCAP 11 A	BCAP 13	BCAP 77	BCAP 78	BCAP 79	BCAP 93

 $^{2/}$  prsy I<sub>C</sub> = 150 mA; U<sub>CE</sub> = 2 V 3/ pray I<sub>C</sub> = 10 aA; U<sub>CB</sub> = 10 V  $^{1/}$  przy  $P_{\rm B} = 0.1$  Å;  $I_{\rm C} = 1$  Å

d układy hybrydowe esterujące małej częstotliwości w układy wejściowe i sterujące małej częstotliwości f układy niskoszumowe małej częstotliwości

## 2.3. Tranzystory malej częstotliwości dużej mocy

				Parame	try gra	niczn	e /t	b = 25°C/			Γ
	ОСВО	UCEO	U <sub>EBO</sub>			t <sub>case</sub>	tj	t amb	t <sub>stg</sub>	Grupa	
Oznaczenie wyrobu	v	y	v	A	W	°c	°c	°c	°C		
· •	max	max	max	max	max		max				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Ţ
BD 135	45	45	5	0,5	6,5	60	125	-40 +100	-55 +125		
BD 136	45	45	5	0,5	6,5	60	125	-40 +100	-55 +125		
BD 137	60.	60	5	0,5	6,5	60	125	-40 +100	-55 +125		
BD 138	60	60	5	0,5	6,5	60	125	-40 +100	-55 +125		
BD 139	80	80	5	0,5	6,5	60	125	-40 +100	-55 +125		
BD 140	80	80	5	0,5	6,5	6,0	125	-40 +100	-55 +125		
BD 354	60	40	5	3	12,5	45	175	-25 +85	-55 +175	A B C	,
BD 355	60.	40	5	3	12,5	45	175	-25 +85	-55 +175	A B C	
BD 643	45	45	5	8	62,5	25	150	-40 +100	-40 +150		
BD 644 <sup>X</sup>	45	45	5	8	62,5	25	150	-40 +100	-40 +150	)	
BD 645	60	60	. 5	8	62,5	25	150	-40 +100	-40 +150		
BD 646 <sup>X</sup>	60	60	5	8	62,5	25	150	-40 +100	-10 +15	0	
BD 647	80	80	5	. 8	62,5	25	150	-40 +100	-10 +15	0	
BD 648 <sup>X</sup>	80	80	5	8	62,5	25	150	-40 +100		1	
BD 649	100	100	5	8	62,5	25	150	-40 +100			
BD 650 <sup>X</sup>	100	100	5	8	62,5	25	150	-40 +100	-40 +15	0	
BDP 279	30	25	3	7	40	25	1	-40 +100	-40 +15	0	
BDP 280	30	0 25	3	7	40	25	150	-40 +100	-40 +15	0	
BDP 281	40	0 30	5	7	40	25	150	-40 ,,, +100	-40 +15	0	
BDP 282	4	0 30	5	7	40	25	150	-40 +100	-40 +15	50	

			Para	ametry	charakt	erystycz	ne /taml	<sub>o</sub> = 25°C/				
1.	h <sub>2</sub>	1E prz	y		f	c <sub>CBO</sub> I	rzy	UCE sat p	rzy			
rupa			Ic	UCE			СВ		I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>	N n-p-n	Zasto-	Obu-
			A	v	LIIIZ	pF	v	v	A/A	P p-n-p	nie	dowa
	min	max		·	min /typ/	max /typ/		xan		р- <b>и</b> -р		
11	1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	40	250	0,15	2	/200/			0,5	0,5/0,05	N	b	ÇE 39
	40	250	0,15	- 2	/150/			0,5	0,5/0,05	P	ъ	CE 39
	40	160 `	0,15	2	/200/			0,5	0,5/0,05	Ŋ	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/150/			0,5	0,5/0,05	P	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/200/			0,5	0,5/0,05	N	b	CE 39
	40	160	0,15	2	/150/			0,5	0,5/0,05	p	b	CE 39
A P C	30 <b>50</b> <b>1</b> 00	90 150 300	1,	2	10		•	0,75	2/0,2	N	а	CE 24
A B C	30 50 100	90 150 300	1	2	10			0,75	2/0,2	P	a	CE 24
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	а	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	a	CE 30
·	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	a T	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	8	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	N	а	CE 30
	750		3	. 3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	а	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	Ń	а	CE 30
	750		3	3	1	/100/	10	2	3/0,012	P	a	CE 30
	25		1	4	3	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30
	25		1	4	8	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30
	30	200	3	4	4	250	10	3,5	7/3	N	c	CE 30
	30	200	3	4	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2
BDP 233	60	50	5	7	40	25	150	-40 +100	-40 +150		30	200
BDP 284	60	50	5	7	40	25	150	-40 +100	-40 +150		30	200
BDP 285	80	70	5	7	40	25	150	-40 +100	-40 +150		30	200
BDP 286	80	70	5	7	40	25	150	-40 +100	-40 +150		30	200
BDP 391	50	40	5	15	75	25	150	-40 +100	-40 +150		20	150
BDP 392	50	40	5	15	75	25	150	-40 +100	-40 +150		20	150
BDP 393	70	60	5	15	75	25	150	-40 +100	-40 +150	٠	20	150
BDP 394	70	60	5	15	75	25	150	-40 +100	-40 +150		20	150
BDP 395	90	80	5	15	75	25	150	-40 +100	-40 +150		20	150
BDP 396	90	80	5	15	75	25	150	-40 +100	-40 +150	. 3.4	20	150
BDP 491 <sup>X</sup>	50	40	5	15	125	25	200	-40 +150	-40 +200		20	
BDP 491	50	40	5	15	125	25	200	-40 +150	-40 +200		20	
BDP 492	70	60	5	15	125	25	200	-40 +150	-40 +200		20	
BDP 494 <sup>X</sup>	70	60	5	15	125	25	200	_40 +150	-40 +200	·	20	
. *		80	5	15	125	25	200	-40 +150	-40 +200		20	
BDP 495 <sup>X</sup>	90				125	25	200	-40 +150			20	
BDP 496 <sup>X</sup>	90	80	5	15	120				,			
BDY 23	60	60	10	6	87,5	25	200	-40 +100	-55 +175	A U	15 30 75	45 90 180
			-							С		
BDY 24	100	90	10	6	87,5	75	200	-40 +100	-55 +175	A B C	15 30 75	45 90 180
	-								55 475		15	45
BDY 25	200	140	10	6	87,5	25	200	-40 +100	-55 +175	B	30 75	90 180

a stopnie mocy, przekuczniki mocy

b stopnie sterujące średniej mocy, komplentarne

e przekączniki mocy, stopnie mocy, stabilizatory

x nowe uruchomienia

					,				<del>,</del>	<del>,                                    </del>
-	13	14	15	16	17	. 18	19	20	21	22
500	.2,5	4	:4	250	<b>1</b> 0.	3,5	7/3	Ŋ	o	CE 30
500	2,5	4	10	250	10	3,5	7/3	P	c	CE 30
500	2	4	4	250	10	3,5	7/3	N	c >	CE 30
200	2	4	10	250	10	3,5	7/3	. <b>P</b>	č	CE 30
150	5	4	. 4			1,3	5/0,5	<del>'N</del>	а	CE 30
150	5	4	4	-		1,3	5/0,8	P	<b>a</b> ·	CL 30
150	5	4	4		-	1,3	5/0,5	N	а	CE 30
150	5	4	4	·		1,3	5/0,5	P	a	CE 30
150	5	; <b>4</b>	4			1,3	5/0,5	N	a	CE 30
150	5	4	4	`		1,3	5/0,5	P	a.	CE 30
	5	4	5			1,3	5/0,5	N	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	P	a	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	Ŋ	а	CE 20
	5	4	5		·	1,3	5/0,5	P	а	CE 20
	5	4	· 8			1,3	5/0,5	N	а	CE 20
	5	4	5			1,3	5/0,5	P	а	CE 20
45 90 180	2	4	10			1	2/0,25	N	c	CE 20
45 90 180	, 2	4	10			0,6	2/0,25	N	c	CE 20
45 90 180	2	4	10			0,6	2/0,25	N	c	CE 20

2.4. Tranzystory małej częstotliwości dużej mocy specjalne

ametry graniczne /t <sub>amb</sub> = 25°C/	ametry graniczne /t <sub>amb</sub> = 25°C/	= 25°C/	= 25°C/	= 25°C/				1 1	,	Para	metry o	Parametry charakterystyczne /tamb	rysty	czne /	11	25°c/			
Oznaczenie	UCEO	осво прво	пЕво	J <sub>C</sub>	Ptot przy	przy t case	τ,	Gruba	h21	h <sub>21E</sub> przy	y I <sub>C</sub>	<b>f</b> T	C <sub>CBO</sub> przy		UCE sat Przy	rzy I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>	N n-q-u	Zasto-	-nqo
maran	>	^	. >	Ą	M.	၁၀	၀	•			4	MHZ	PF	>	Λ	A/A	Ω.	nie	dowa
	пах	max	max	тах	пах		пах,		nin	шаж		nin /typ/	пах		пах	1	<b>d</b> -u-d		
#	83	က	4	2	9	7	ю	6	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
BDAP 35	45	45	າລ	0,5	6,5	09	125		40	250	0,15	/500/	<del></del>		0,5	0,5/0,05	Z	Q	CE 39
BDAP 36	45	45	cy	0,5	6,5	09	125		04	250	0,15	/150/		-	8,0	0,5/0,05	ρ,	۵	CE 39
BDAP 37	09	09	מו	0,5	6,5	69	125		40	160	0,15	/500/			0,5	0,5/0,05	z	۵	CE 39
BDAP 38	09	09	מו	0,5	6,5	09	125		04	160	0,15	/150/			0,5	0,5/0,05	C4	م	CE 33
BDAP 39	80	80	ю	0,5	6,5	09	125		40	760	0,15	/500/	·····		0,5	0,5/0,05	z	م	CE 39
BDAP 40	80	80	10	0,5	6,5	9	125		40	160	0,15	/150/		<del>, :</del>	0,5	0,5/0,05	<b>4</b>	۵	CE 39
BDAP 54	09	40	ស	es .	12,3	45	175	4 pa U	1000	90 300		30	0.2	10	0,75	2/0,2	z	đ	CE 24
BDAP 55	09	40	<b>10</b>	n	12,5	7 <del>4</del>	175	<b>∢</b> @∪	100	300		30	10	10	1,0	2/0,2	Ω,	đ	CE 24
BDAP 81	40	30	'n	~	40	22	150		၁၀	500		4	250	10	3,5	1/3	z	ပ	CE 30
BDAP 82	0#	30	io.	۲-	07	22	150		30	500		10	250	10	3,5	1/3	<u></u>	ပ	CE 30
BDAP 83	9	20	ю	· -	40	22	150	,	30	500	2,5	4	250	10	3,5	1/3	z	o	CE 30
BDAP 84	9	20	ю	۲-	40	22	150	•	30	500	2,5	10	250	10	3,5	1/3	C <sub>4</sub>	0	CE 30
BDAP 85	80	70	ю	۰	<b>4</b> 0	22	150		30	500	 N	4	250	10	3,2	1/3	z	v	CE 30
															4				

	1							
19	CE 30	CI. 20	CE 20	CF 50	CE 20	CE 20	CE 30	CI: 50
18	ပ	ಪ	43	Ø	Ø	. 0	a	٥
17	c,	Z	F4	z	o.	z	Д	Z
16	7/3	5/0,5	5/0,5	5/0,5	5/0,5	5/0,5	5/0,5	2/0,28
15	3,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	т С	9,0
14	10			7				
13	250							·
12	10	ra	ĸ	ß	10	ıa	NO.	10
11	Ø	מו	r3	10	Ŋ	ស	10	Ø
10	200				-			45 90 180
F	30	20	20	50	20	20	20	15 30 75
6								4-10
80	150	200	200	200	200	200	200	200
2	2,2 10	52	22	52	52	25	<b>19</b>	<b>19</b>
9	<b>0</b>	125	125	125	125	125	125	87,5
NO.	<b>F</b>	9	12	12	15	12	1.5	- φ
*	ю	مد	מ	ю	מי	10	ıo.	10
6	0.	<b>\$</b>	•	9	09	80	08	140
21	80	20	20	70	70	8	06	200
-	BDAP 86	BDAP 91X	BDAP 92*	BDAP 93X	Buap 94x	BDAP 98*	DDAP 96*	BDCP 25

a stopnie mocy, przełączniki mocy b stopnie sterujące średniej mocy, komplementarne c przełączniki mocy, stopnie mocy, stebilisatory

nowe uruchomienia ×

### 2.5. Tranzystory wielkiej częstotliwości

				Par	ametr	y grani	iczne	$/t_{amb} = 25^{\circ}C/$				····
Oznacze:		U <sub>СВО</sub>	u <sub>CEO</sub>	U <sub>EBO</sub>		Ptot	<sup>t</sup> j	t <sub>amb</sub>	tstg	Grupa	h <sub>21</sub>	E <sup>pr</sup>
wyrob		v	v	v	mΑ	m\V	°c	°c	°c	orupa		
		max	max	max	max	max	max				min	max
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BF 167		40	30	4	25	150	175	-40 +125	-65 +175		25	,
BF 173		40	25	4	25	230	175	-40 +125	-65 +175		40	
BF 180		30	20	3	20	150	175	-40 +125	-55 +175		15	
BF 181		30	20	3	20	150	175	-40 +125	-55 , +175		20	
BF 182		30	20	3	20	150	175	-40 +125	-85 +175		10	
BF 183		30	20	3	20	150	175	-40 +125	-85 +175		10	
BF 194		30	20	4	30	160	125	-40 +125	-65 +125		67	225
BF 195		30	20	4	30	160	125	-40 +125	-65 +125		35	125
BF 196		40	30	4	25	160	125	-40 +125	-65 +125		30	
BF 19 <b>7</b>		40	25	4	· 25	250	125	-40 +125	-65 +125		40	-
BF 200	)	30	20	3	20	150	175	-40 +125	-55 +175		15	
BF 214		30	30	4	30	165	175	-40 +125	-55 +175		90	330
pm 945		30	30	4	30	165	175	-40 +125	-55 +175		40	165
BF 215		40	40	4	25	300	150	-25 +85	-55 +150		67	220
BF 241		40	40	4	25	300	150	-25 +85	-55 +150		36	12
BF 257		160	160	5	100	5 W <sup>1</sup> /	1	-40 +125		1	25	
BF 258		250	250	5	100		i	-40 +125	-55 +175		25	
BF 259		300	300	5	100		175	-40 +125	-55 +175		25	
BF 314		30	30	4	25		150	-25 +85	-55 +150	,	29	
BF 414		40	30	4	25	3002/	150	-40 +125	-55 +150	,	30	
BF 44		40	40	4	25	3002	150	-40 +125	-55 +150		60	22
8F 44		40	40	4	25	,	1	-40 +125	-55 +150	)	30	12

_	·		]	Parametr	y charak	teryst	yczne /1	amb =	25°C/	<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1 <sub>2</sub>	1E prz	y	•	f	C <sub>12es</sub>		r <sub>bb</sub> , c <sub>c</sub>			Fp	rzy	_	_			
		UCE	I <sub>C</sub>		/c <sub>CBO/</sub>	UCE/	·	I <sub>C</sub>	n <sup>CE</sup>		n <sup>CE</sup>	ıc	f <sub>p</sub>	N n-p-n	Za- sto-	Obu-
		v	mA	MHz	pF	v	рs	mA	v	đВ	v	mA	MHz	P p-n-p	wa- nie	dowa
1	max		,	min /typ/	max		max			typ				p-u-p		,
1	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
;		10	4	250	0,25	10	12	4	10					N	a	CE 25
)		10	7	350	0,3	10	10	7	10					N	a	CE 25
<b>5</b>		10	2	500	0,4	10	• 4	2	10	8	10	2	800	N	e	CE 25
)		10	2	400	0,4	10	4	2	10				· .	N	h	CE 25
)		10	2	550	0,5	10	6	2	10					N	,e	CE 25
)		10	2	550	0,5	10	6	3	10				٠.	N	е	CE 25
ľ.	225	10	1	150	1	10	17	5	10	1,5	10	1	0,2	N	đ	CE 36
į	125	10	1	150	1 \	10	11	5	10	-4	10	1	100	N	d	CE 36
)		10	4	250	0,3	10	12	4	10					N	a	CE 36
)		10	7	350	0,35	10	10	7	10					N	a	CE 36
j		10	2	400	0,4	10	6	2	10	5	10	2	200	N	8	CE 25
<b>)</b>	330	10	1	250	0,7	10	12	1	10	3,5	10	1	1	N .	đ	CE 25
)	165	10	1	150	0,7	10	15	1	10	3,5	10	1	1.	N	đ	CE 25
1.5	220	10	1	/430/	0,34	/10/				4	/10/	1	0,3	N	đ	CE 35
; ;	125	10	1	/400/	0,34	/10/				4	/10/	.1	0,3	N	d	CE .35
;		10	30	40										N	g	CE 23
,		10	30	40										И	g	CE 23
i		10	30	30			_				f			N	g	CE 23
ı		10	4	/450/	0,13	/10/				4	/10/	· <b>1</b>	100	N	đ	CE 35
•		10	1	/400/						2	/10/	1	100	P	đ	CE 35
,	220	10	1	/250/	0,4	/10/	,			3	/10/	1	0,3	P	đ	CE 35
,	125	10	1	/250/	0,4	/10/		1		3	/10/	1	0,3	P	d	CE 35
	L	L	L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<del>,</del>	<u> </u>	<b></b>	L	<u></u>	<u></u>	1	<u> </u>	L	A 6

Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	BF 457	160	160	5	100	1,2 W	150	-40 +100	-55 +150		25		10	30
	BF 458	250	250	5	100	1,2 W	150	-40 +100	-55 +150		25		10	30
	BF 459	300	300	5	100	1,2 W	150	-40 +100	-55 +150		25		10	30
	BF 469 <sup>X</sup>	250	250	5	30	1,25 W	150	-40 +100	-55 +150		50		20	25
	BF 470 <sup>X</sup>	250	250	5	30	1,25 W	150	-40 +100	-55 +150		50		20	25
	BF 519	70	50	5	50	300	150	-40 +125	-55 +175	II III V VI	20 30 70 150	35 90 170	6	10
	BF 520	50	30	5	50	300	150	-40 +125	-55 +175	11 111 <b>V</b>	20 30 70	35 90 170	6	10
	BF 521	30	15	5	50	300	150	-40 +125	-55 +175	II III V VI	20 30 70 150	35 90 170	6	10
	BF 619	70	50	5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	A B C D	20 30 70 150	35 90 170	6	10
	BF 620	50	30	5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	A B C D	20 30 70 150	35 90 170	6	10
	BF 621	30	15	5	50	300	150	-25 +85	-55 +150	A B C D	20 30 70 150	35 90 170	6	10
	BFE 214 <sup>X</sup> BFE 214R <sup>X</sup>	30	30	4	30	150	175	-40 +125	-55 +175		90	330	10	1
	BFE 215 <sup>X</sup> BFE 215R <sup>X</sup>	30	30	4	30	150	175	-40 +125	-55 +175		35	165	10	1
	BFS 18X BFS 18RX	30	20	5	30	200	150	-40 +125	-55 +150		35	125	10	1
	BFS 19 <sup>X</sup> BFS 19R <sup>X</sup>	30	20	5	30	200	150	-40 +125	-55 +150		65	225	10	1

a pośrednia TV

b uniwersalne

c układy hybrydowe

d głowice VHF, pośrednia AM/FM

e wzmacniacze UHF

układy wysokonapięciowe małej mocy

wzmacniacze UHF

nowe uruchomienia

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	/60/	/4,5/	30								N	g	CE 39
30	/60/	/4,5/	30								N	g	CE 39
30	/60/	/4,5/	30								N	g	CE 39
25	60	/1,8/	/30/	<b>9</b> 0	10	/20/					N	g	CE 39
25	60	/1,8/	/30/	90	10	/20/					P	8	CE 39
10	150	/8/	/10/	500	. 5	/10/					N	b	CE 22
10	150	/8/	/10/	500	5	/10/	·				N	b	CE 22
	·												
10	150	/8/	/10/	500	5	/10/					Ŋ	b	CE 22
				·									
10	150	/6/	/10/	500	5	/10/				•	Ħ	b	CE 35
								:	ŧ.				
10	150	/6/	/10/	500	5	/10/					N	b	CE 35
											; !		
10	150	/6/	/10/	500	5	/10/					N	ь	CE 35
	100		, 10,			, 20,				ξ.			
1													
1	150	1	10	22	1	10	3,5	10	13	100	N	.0	CE 45
1	150	1	10	<b>15</b> -	1	10	3,5	10	1	100	N	o	CE 45
1	/200/	0,85	10				4	10	1	100	N	o	CE 46
	/260/	0,85	10				4	10	1	100	N	0	CE 46
1	/200/	0,83	10			1	-						

<sup>1/</sup> przy  $t_{\text{case}} \leq 60^{\circ}$ C

<sup>2/</sup> prsy t<sub>mah</sub> ≤ 45°C

#### 2.6. Tranzystory wielkiej częstotliwości specjalne

	P	arametry	granic	zne /t <sub>an</sub>	<sub>1b</sub> = 25°C	/				Pa	rametry
	U <sub>СВО</sub>	UCEO	UEBO	1 <sub>C</sub>	Ptot	tj	h	211. prz	гу	f	C <sub>12es</sub> p
Ormograpia	020								1 <sub>C</sub>		
Oznaczenie wyrobu	V	V	V	mA	mo	°c			щА	MHz	pF
	Bax	max	max	max	max	max	min	max		min	шах
1	2	3	4	5	6	7	8	3	.9	10	11
BFAP 15	30	30	4	30	165	175	40	165	1	150	0,7
BFAP 57	160	160	5	100	5 W.	175	25		30	40	
BFAP 58	250	250	5	100	5 WV	175	25		30	40	
BFAP 59	300	300	5	100	5 W <sup>1/</sup>	175	25		<b>30</b>	40	
BFAP 80	30	2,0	3	20	150	175	15		2	500	0,4
BFAP 83	30	20	3	20	150	175	10		2	630	0,5

a główice VHF, pośrednia AM/FM

$$1/_{\text{przy }t_{\text{case}}} \leq 60^{\circ}\text{c}$$

#### 2.7. Tranzystory polowe złączone (FET): kanał n

1			F	arame	try gra	niczn	e /t <sub>amb</sub> = 25°	C/						
	Ozna-`	U <sub>GD</sub>	U <sub>DS</sub>	I <sub>G</sub>	P <sub>tot</sub>	<sup>t</sup> j	t <sub>amb</sub>	t <sub>stg</sub>	Gru-	I DS:	przy	u <sub>GS</sub>	<sup>U</sup> DS	
	czenie wyrobu	v	v	mA	m\Y	°c	°c	°c	pa		4	٧	٧	
ľ		max	max	max	max	max				Min	max			cair
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
	BF 245	30	30	10	360	150	-40 +100	-55 + <b>150</b>	A B C	2 6 12	6,5 15 25	0	15	-0, -1, -3,
	BFR 30 <sup>X</sup>	25	25	5	200	150	-40 +125	-65 +150		4	10	0	10	
	BFR 31 <sup>X</sup>	25	25	5	200	150	-40 +125	-65 +150		1	5	0	10	

c układy hybrydowe

b wzmacniacze VHF

d układy wysokonapięciowe

f wzmacniacze niskoszumowe

## BF spec

aı,	rametry	charakt	erystyczne	/t <sub>amb</sub> =	25°C/						
	C <sub>12es</sub>	przy	r <sub>bb</sub> , c c	rzy	Fpr	ʻzy			N		
		UCE		1 <sub>c</sub>		UCF	ı <sub>c</sub>	fp	n-p-n	Zasto-	
	pF	V.	ps	mA	dB	v	此人	MIZ	P	sowa- nie	Obudowa
	max		max		max				p-n-p		
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 -
	0,7	10	15	1	3,5	10	. 1 1	100	N	a	CE 25
									N	d	CE 23
			·						N	a	CE 23
									N	a	CE 23
	0,4	10	4	2	7	10	2	800	N	ъ	CE 25
	0,5	10	6	3				•	N	b	CE 25

## BF FET

·····	<del></del>	Para	metry	charak	terst	yczne .	/t <sub>amb</sub>	= 25°C	/						
		$oldsymbol{v}_{\hat{\mathbf{G}}\mathbf{S}}$	prz	У		UGSS	off P	rzy		C <sub>1288</sub>	przy				
UDS				u <sub>DS</sub>	ın			u <sub>DS</sub>	ID		UDS	UGS	fp	Zasto-	UDU~
V		V		v	عنز	,	٧	V	n.A.	pF	V	V	MHz	nie	dowa
	nin	/typ/	IDAX		5	·min	max			max					
12		13		14	15	10	3	17	18	19	20	21	22	23	24
15	-0, 4 $-1, 6$ $-3, 2$		-2,2 -3,8 -7,5	15	200	-0,5	-8	15	10	1,1	20	-1	1	f	CE 35
10		/-4/		10	50					1,5			1	c	CE 46
10.		/-2/	,	10	50					1,5			1	С	CE 46

### 2.8. Tranzystory przełączające $/t_{amb} = -40^{\circ}c$ ... $+125^{\circ}c$ , $t_{stg} = -65^{\circ}c$ ... $+150^{\circ}c/c$

	Par	ametry	graniczn	ne /t <sub>am</sub>	b = 25°	C/						Pa	rametr	y chai
	UCBO	UCEO	U <sub>EBO</sub>	1 <sub>C</sub>	Ptot	t <sub>j</sub>	h <sub>2</sub>	1E pr	zy		f	СВО	przy	UCE
Oznaczenie			:						UCE	1 <sub>C</sub>			U <sub>C</sub> B	
wyrobu	Ÿ	v	v	ш.	m./	°c		T T	v	m.A.	MIIz	pF	V	ľæ
	max	max	max	пах	max	max	min	max			min	max		max
1	2	3	4	5	6	7	į	3	9	10	11	12	13	14
BSV 52 <sup>x</sup> BSV 52R <sup>x</sup>	20	12	5	100	200	150	40	120	1	10	400	4	5	40
						` `								

x nowe uruchomienia

#### 2.9. Tranzystory dużej mocy wysokonapięciowe

				Param	etry gra	niczne /	tamb =	25°C/		
Oznaczenie wyrobu	UCES/	UCEO	U <sub>ЕВО</sub>	<sup>T</sup> c	Ptot P	rzy tcase	t <sub>j</sub>	tamb	<sup>t</sup> stg	
"yronu	v	ν'	γ	A	W	°c	°c	°с	°c	
	max	max	max	max	max		max			miı
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BU 201 <sup>x</sup>	1300	600	5	2,5	10	90	115	-40 +100	-65 +115	1
BU 205 <sup>X</sup>	1500	700	5	2,5	10	90	115	-40 +100	-65 +115	;
BU 206 <sup>x</sup>	1700	<b>600</b>	5	2,5	10	90	115	-40 +100	-65 +115	. :
BU 126 <sup>X</sup>	/750/	300	6	3	30	50	125	-65 +125	-65 +125	11
BU 326 <sup>x</sup>	/800/	375	6	6	60	50	150	-65 +125	-65 +150	11
BUP 406 <sup>X</sup>	400	200	6	7	60	25	150			
BUP 407X	330	150	6	7	60	25	150			4.
BUP 323*	500	350	8	10	175	25	200			15
BUYP 52	120	70	5	5	/50/	25	150	-40 +100	-40 +150	1
BUYP 53	80	50	5	5	/50/	25	150	-40 +100	-40 +150	2
BUYP 54	40	30	5	5	/50/	25	150	-40 +100	-40 +150	2

a układy odchylenia poziomego

b układy zapłonowe

c układy przeł czajnee mocy, stabilizatory, wzmacniacze

d zasilacze impulsowe

у	UCE sat przy		$t_{amb} = 25^{\circ} \text{C/}$		ton przy		toff przy		1		
CB		I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>		I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>		I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>		I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>	n-p-n	nie	Obudo- wa
v	mV	mA	ns	mA	ns	m.A.	ns	mA	P		
	max		max		max		max		p-n-p		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	400	50/5	13	10/10	12	10/3	18	10/3	N	układy hybry- dowe	CE 46

BU

		arametry charakterystyczne /t <sub>amb</sub> = 25°C/								
	h	h <sub>21E</sub> przy			f <sub>T</sub>	f <sub>T</sub> U <sub>CE sat przy</sub>				
			ı <sub>c</sub>				I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>	N	Zasto- sowanie	Obudo-
			A	V	MHz	v	A/A	n-p-n	30 4 4 5 5	wa.
-	min	max			min /typ/	max				
		Li	12	13	14	15	16	17	18	19
;	2,0		2	5	/7,5/	5	2/1	N	8	CE 20
5	2,0		2	5	/7,5/	5	2/1	N	<b>a</b> ,	CE 20
;	1,8		2	5	/7,5/	5	2/1	N	a	CE 20
,	15	60	1	5	6	10	2,5/0,25	N	đ	CE 20
)	15		0,6	5	6	10	2,5/0,25	N	a	CE 20
					10	1	5/0,5	N	a	CE 30
	-				10	1	5/0,5	N	a	CE 30
	150	2000	3	6		1,5	3/0,06	N	b	CE 20
)	10		0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	C	CE 20
,	20		0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	c	CE 20
	20		0,5	5	10	0,35	0,5/0,05	N	0	CE 20

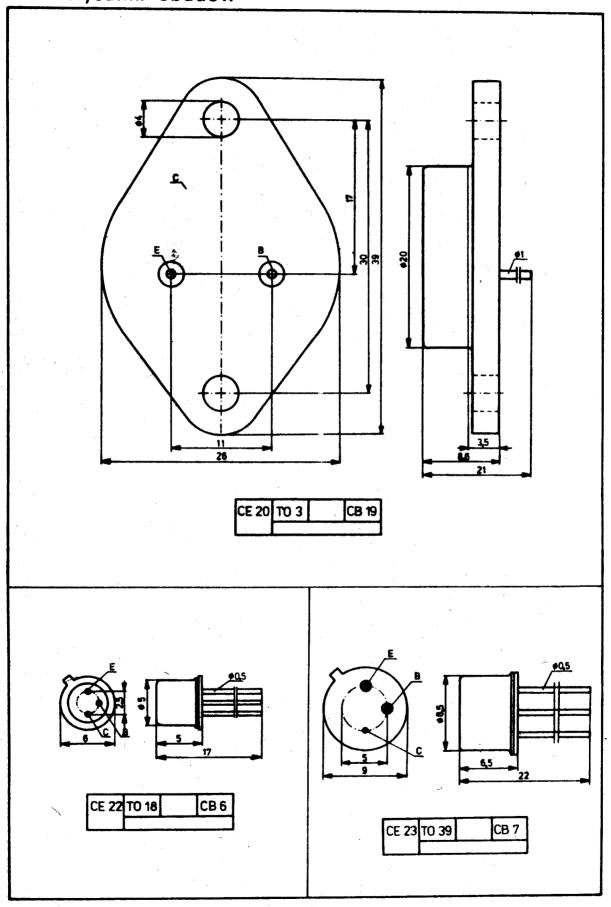
cniacze mocy

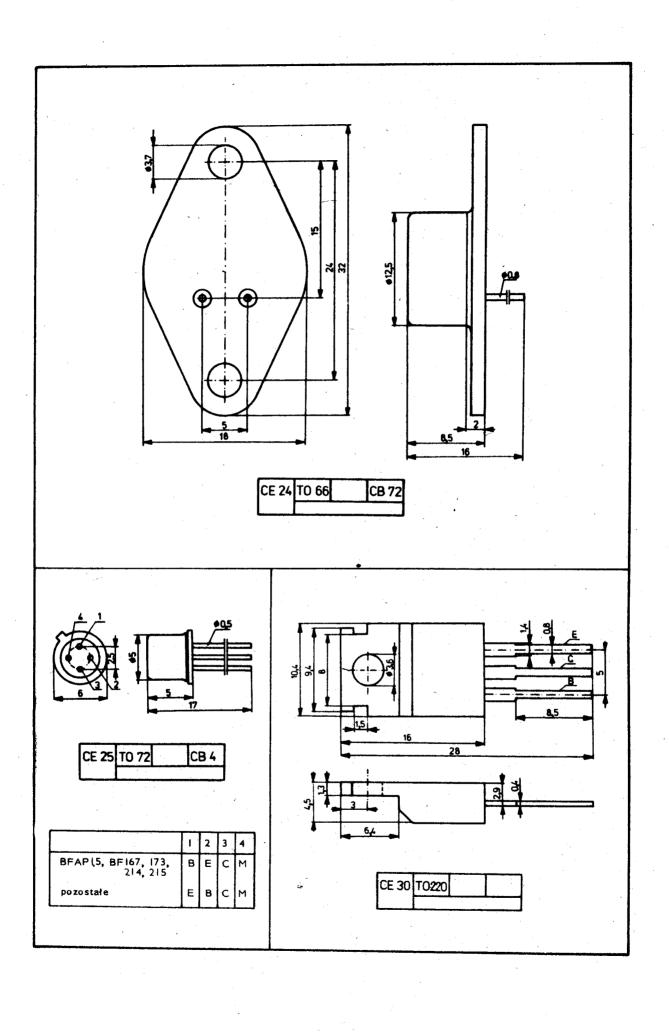
x nowe uruchomienia

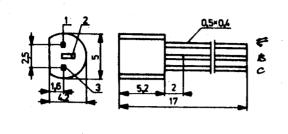
2.10. Tranzystory dużej mocy wysokonapięciowe specjalne

		cpingo-	878	16	CB 20	
Zastosowani					15	układy prze- łączające i wzmacniające mocy, stabiliza- tory
u-č-u N					14	N
Parametry charakterystyczne /t <sub>amb</sub> = 25°C/	przy	$_{\rm C/I_B}$	A/A	-	13	5/0,5
tyczne /ta	UCE sat przy		V	max	12	a
rakterys	Ţ		ZHT	uţw	11	10
try cha	h <sub>21E</sub> przy	$^{1}\mathrm{c}$	A		10	0,5
Parane				uţu	6	10
	f <sub>3</sub>		ာ့	xem	8	150
/tamb = 25°C/	zy	tcase	ာ္စ	-	7	25
e /tamb	P <sub>C</sub> przy		Æ	xem	9	80
raniczn	ıc		Ą	M.S.X.	5	מ
Parametry graniczne	UEBO		Λ	max	4	ၓ
Par	UCEO		Λ	max	3	0.1
	UCBO		۸	хөш	83	120
-		0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Wyrobu		+	BUCP 52

2.11. Rysunki obudów



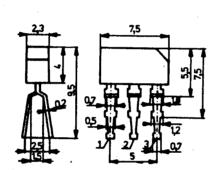




CE 35 TO 92

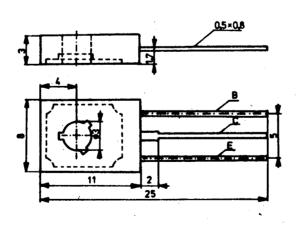
CB 97

	1	2	3
BF245	D	S.	000
BF240—I, BF440—I	B	E	
pozostałe	E	B	



	Ti	2	3
BF194 197	В	E	С
pozostałe	E	В	С

CE 36		CB 13
1		



CE 39 TO 126 SOT 32 CB 16

